

半 导 体 学 报

第 9 卷 第 6 期 1988 年 11 月

目 录

InGaAs-GaAs 应变量子阱的光学性质	
.....徐仲英 许继宗 葛惟锬 郑宝真 I. G. Andersson, Z. G. Chen (563)	
八毫米 GaAs 梁式引线肖特基势垒混频管	王良臣 方浦明 郑 东 (570)
工艺模型参数的优化提取和 MICPOS 工艺模拟程序	郑 颖 夏武颖 (578)
薄膜生长及界面结构的计算机模拟	田民波 王英华 梁春富 (586)
一个基于整体优化分析的区域布线算法——DRAFT	
.....应昌胜 洪先龙 王尔乾 (596)	
(Si) _{2n} /(Si _{1-x} Ge _x) _{2m} (100) 形变层超晶格的电子结构	
.....沈丁立 张开明 (604)	
聚合物半导体聚乙炔的热激电流谱研究	
.....袁仁宽 黄振春 郑有炆 曹 阳 孙鹤才 (614)	
半导体条形 DH 激光器中本征自脉动的精确理论	郭长志 丁 凡 (621)
半导体条形 DH 激光器在高速调制下光相位分布不均匀效应的精确理论 ..	
.....郭长志 丁 凡 (630)	
一种新的硅氧化方法——氟化氢增强氧化	龙 伟 徐元森 郑养铎 (640)
氧化铁气体传感器研究 II. α -Fe ₂ O ₃ 气敏特性	曾桓兴 王 弘 沈瑜生 (648)
计算半导体中杂质能级的分区变分方法	薛舫时 (654)

研 究 简 报

1.3 微米 InP/InGaAsP 多层限制掩埋新月型激光器	
.....肖建伟 薄报学 衣茂斌 马玉珍 高鼎三 (665)	

研 究 快 报

非晶 InP 薄膜的光学性质与退火效应	陈树光 黎锡强 (668)
远紫外无显影光刻催化剂及工艺探讨	韩阶平 侯豪情 (671)
硅中注入氢后形成的稳定性缺陷	李建明 (674)